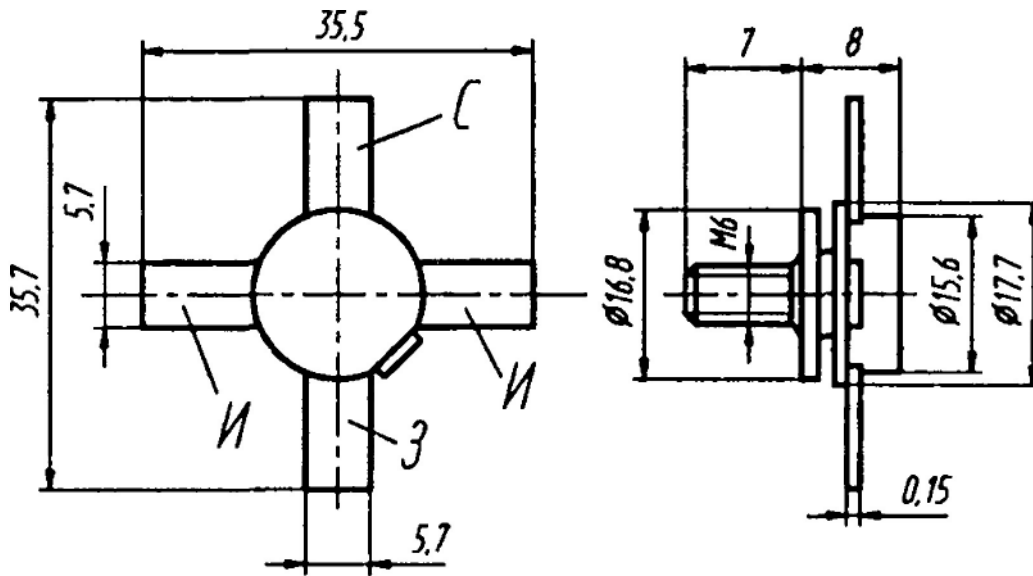


2П913А, 2П913Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с изолированным затвором и каналом л-типа. Предназначены для усиления и генерирования сигналов в диапазоне частот до 400 МГц в непрерывном и импульсном режимах при напряжении питания не более 45 В, а также в переключающих устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с полосковыми выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 12 г.

2П913 (А,Б)



Электрические параметры

Выходная мощность при $f = 400$ МГц, $U_{СИ} = 45$ В:

$P_{ВЫХ} = 50$ Вт для 2П913А 100...105*...
120* Вт

$P_{ВЫХ} = 35$ Вт для 2П913Б 70...80*...
90* Вт

Коэффициент усиления по мощности
при $f = 400$ МГц, $U_{СИ} = 45$ В:

$P_{ВЫХ} = 100$ Вт для 2П913А 4...4,5*...5* дБ

$P_{ВЫХ} = 70$ Вт для 2П913Б 4...4,7*...
5,4* дБ

Коэффициент полезного действия
при $f = 400$ МГц, $U_{СИ} = 45$ В:

$P_{ВЫХ} = 100$ Вт для 2П913А 46...48*...50*%

$P_{ВЫХ} = 70$ Вт для 2П913Б 40...45*...49*%

Крутизна характеристики при $U_{сн} = 20$ В, $I_c = 3$ А	1...1,6*... 2,5* А/В
Ток стока при $U_{сн} = 20$ В, $U_{зи} = 20$ В:	
2П913А	14...16*...19* А
2П913Б	10...12*...14* А
Остаточный ток стока при $U_{сн} = 50$ В, $U_{зи} = -10$ В	20*...100*... 200 мА
Ток утечки затвора при $U_{зи} = -25$ В, не более	1* мкА
Начальный ток стока при $U_{сн} = 20$ В, $U_{зи} = 0$, не более:	
$T = +25$ °С	300 мА
$T = -60$ °С	300 мА
$T = +125$ °С	1000 мА
Емкость затвор—исток при разомкнутом вы- воде стока и $f = 1$ МГц, $U_{зи} = 25$ В	300*...350*... 390* пФ

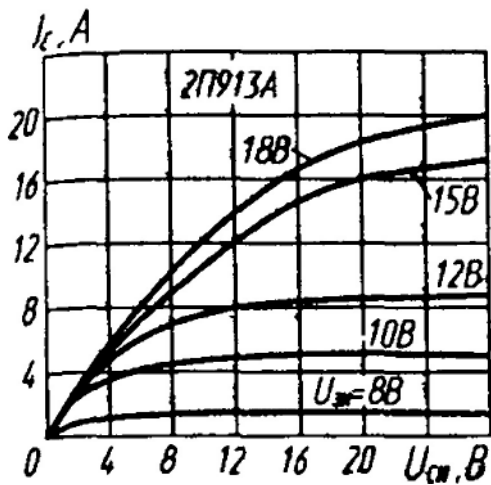
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение сток—исток	50 В
Напряжение сток—исток в динамическом ре- жиме	65 В
Постоянное напряжение затвор—сток	60 В
Напряжение затвор—сток в динамическом ре- жиме	75 В
Постоянное напряжение затвор—исток	20 В
Постоянная рассеиваемая мощность ¹ :	
$T = -60...T_k = +40$ °С	100 Вт
$T_k = +125$ °С	20 Вт
Температура окружающей среды	$-60...T_k =$ $= +125$ °С

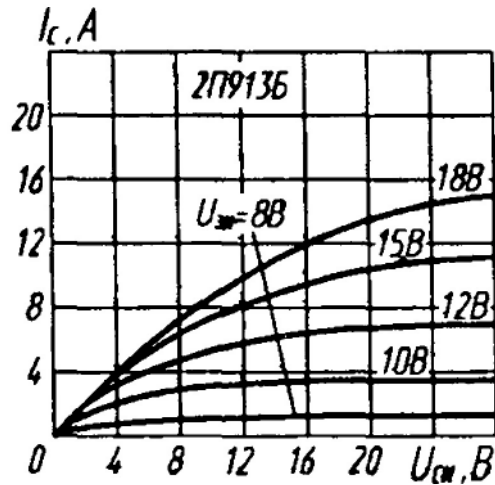
¹ В диапазоне температур $T_k = +40...+125$ °С мощность снижается линейно.

Минимальное расстояние места пайки выводов от корпуса транзистора 3 мм. Температура пайки не более +260 °С, время пайки не более 3 с. Допускается сварка выводов не ближе 0,5 мм от корпуса. При этом температура корпуса транзистора не должна превышать +150 °С.

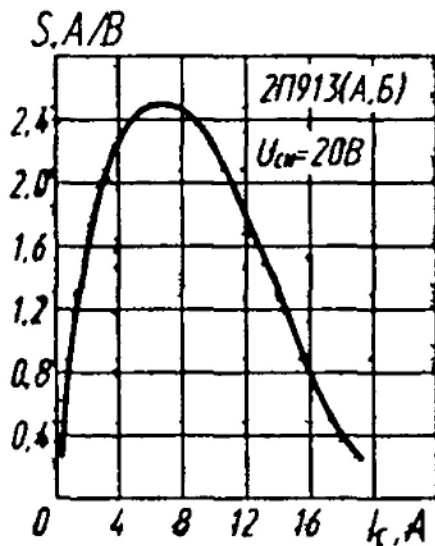
Работа на согласованную нагрузку допускается при использовании транзисторов в усилителях мощности с напряжением питания не более 30 В.



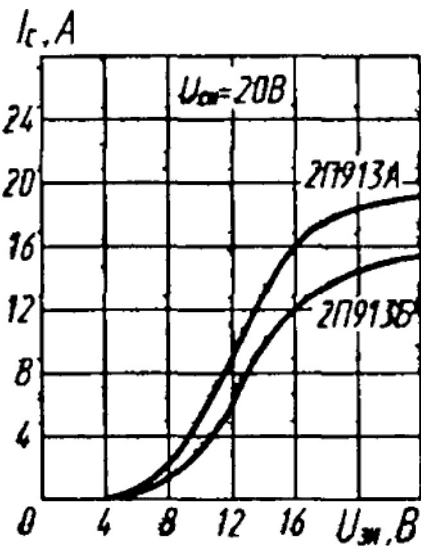
Выходные характеристики



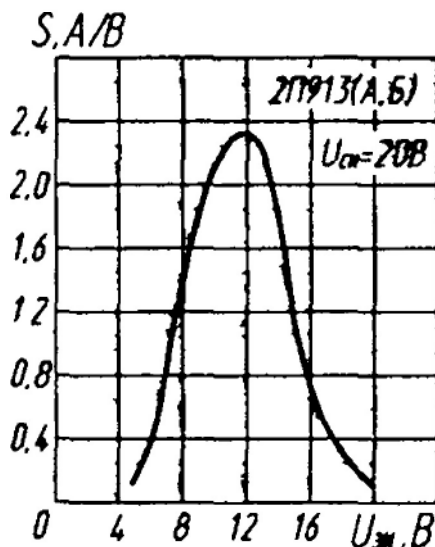
Выходные характеристики



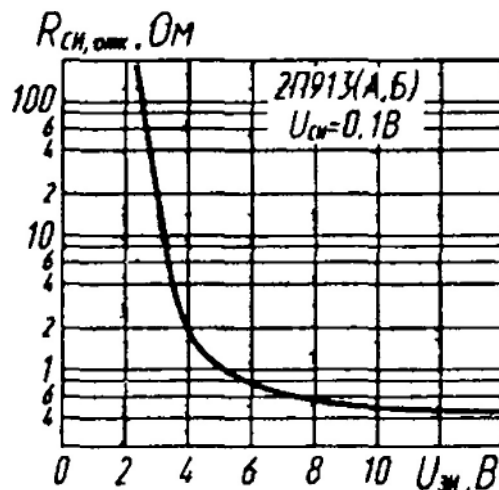
Зависимость крутизны характеристики от тока стока



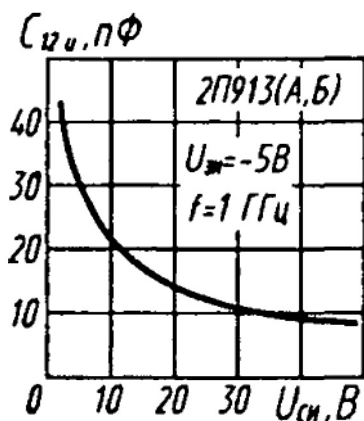
Зависимости тока стока от напряжения затвор—исток



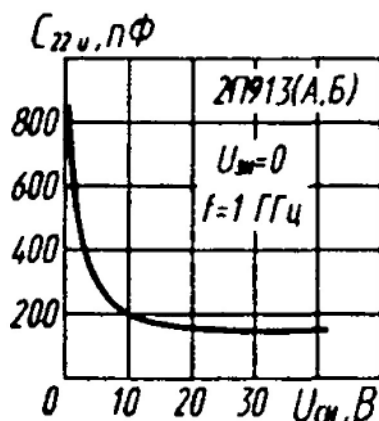
Зависимость крутизны характеристики от напряжения затвор—исток



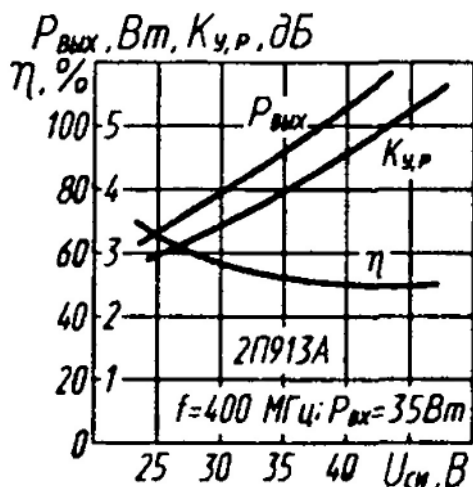
Зависимость сопротивления сток—исток в открытом состоянии от напряжения затвор—исток



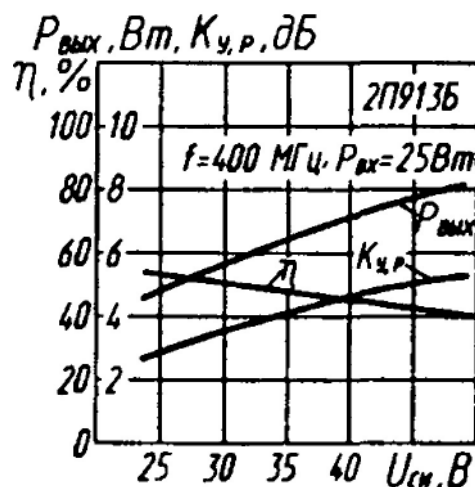
Зависимость проходной емкости от напряжения сток—исток



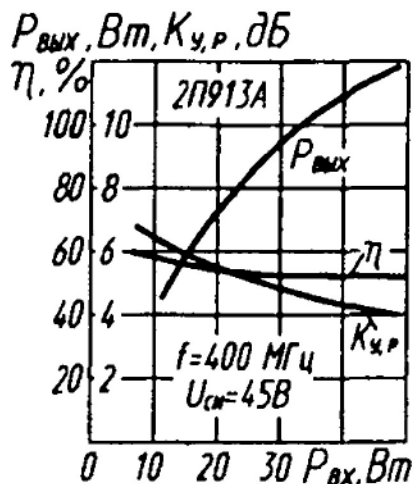
Зависимость выходной емкости от напряжения сток—исток



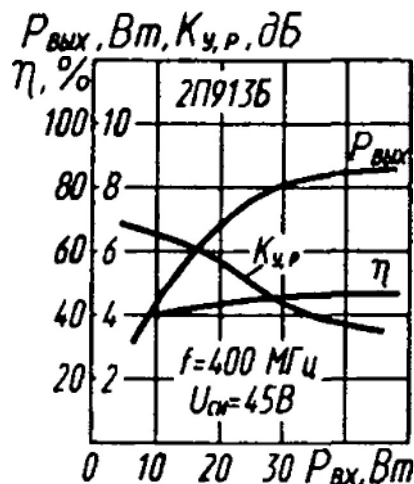
Зависимости выходной мощности, коэффициентов усиления по мощности и полезного действия от напряжения сток—исток



Зависимости выходной мощности, коэффициентов усиления по мощности и полезного действия от напряжения сток—исток



Зависимости выходной мощности, коэффициентов усиления по мощности и полезного действия от входной мощности



Зависимости выходной мощности, коэффициентов усиления по мощности и полезного действия от входной мощности